

PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009676 1

電界効果トランジスタ

2SK247

2SK247

T-29-25

シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

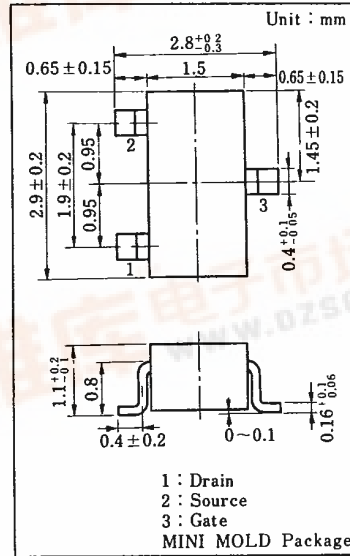
広帯域低雑音増幅 / Wide-Band, Low-Noise Amplifier

■ 特 徴 / Features

- 入力容量 C_{iss} が小さい。 / Low C_{iss}
- 相互コンダクタンス g_m が大きい。 / High g_m

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Value	Unit
ゲート・ドレイン電圧	V_{GDO}	15	V
ゲート・ソース電圧	$-V_{GSO}$	15	V
ドレイン電流	I_D	20	mA
ゲート電流	I_G	5	mA
許容損失	P_D	150	mW
チャンネル部温度	T_{ch}	100	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ C$

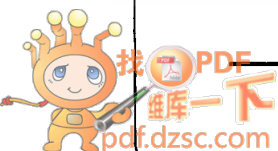


■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS} = 5V, V_{GS} = 0$	0.5		12	mA
ゲートシャ断電流	I_{GSS}	$-V_{GS} = 7V, V_{DS} = 0$			2	nA
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDO}$	$I_D = 10 \mu A$	15			V
ゲート・ソース電圧	$-V_{GSO}$	$I_G = 10 \mu A$	15			V
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{DS} = 5V, I_D = 100 \mu A$			3	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS} = 5V, V_{GS} = 0, f = 1 kHz$	3			mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 5V, V_{GS} = 0, f = 1 MHz$		7.5		pF

* I_{DSS} ランク分類 / I_{DSS} Classifications

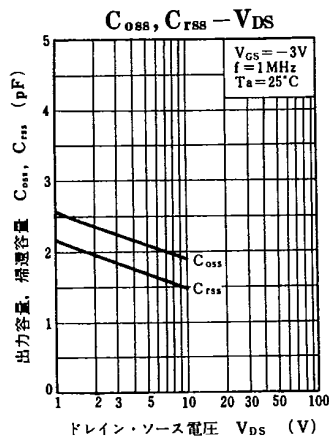
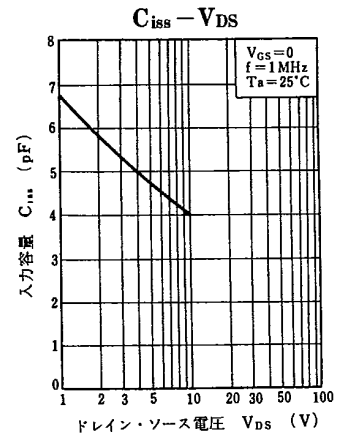
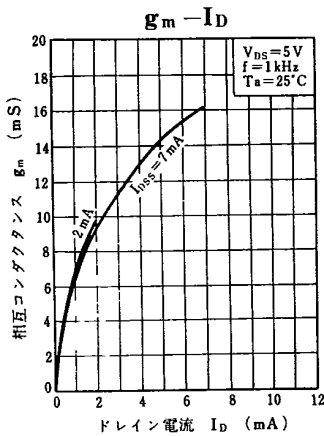
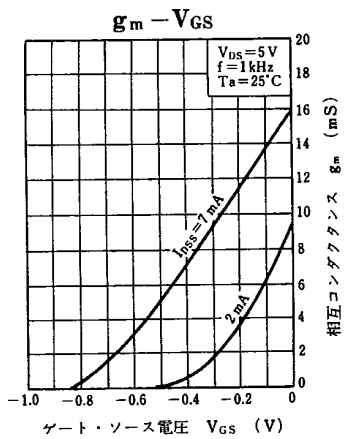
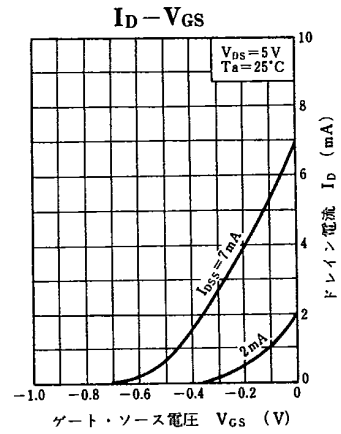
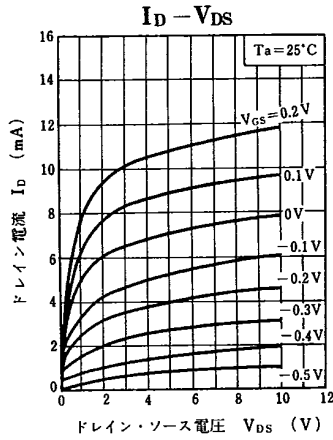
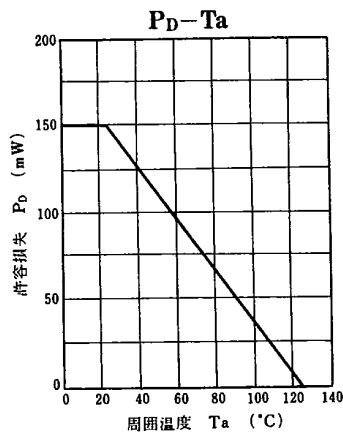
Class	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	0.5~1.5	1~3	2~6	4~12
Marking Symbol	1LP	1LQ	1LR	1LS



電界効果トランジスタ

2SK247

T-29-25



電界効果トランジスタ

2SK301

2SK301

T-29-25

シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

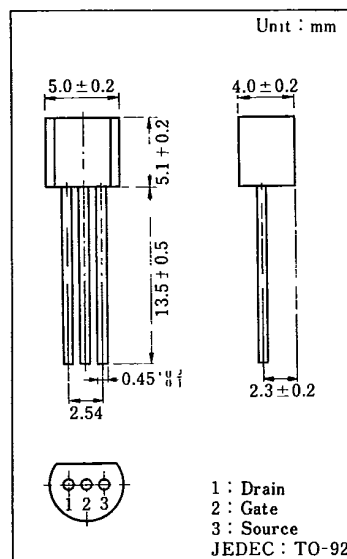
低周波増幅用, スイッチング用 / AF Amplifier, Switching

■ 特徴 / Features

- 低雑音, 高利得 / Low-noise, high gain
- ゲート・ドレイン電圧 V_{GDO} が高い。 / High V_{GDO}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSX}	55	V
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDO}$	55	V
ゲート・ソース電圧	$-V_{GSO}$	55	V
ドレイン電流	I_D	30	mA
ゲート電流	I_G	10	mA
許容損失	P_D	250	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$



電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0$	0.5		20	mA
ゲートシャ断電流	$-I_{GSS}$	$-V_{GS} = 30\text{ V}, V_{DS} = 0$			10	nA
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDS}$	$-I_G = 100\ \mu\text{A}, V_{DS} = 0$	55			V
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{DS} = 10\text{ V}, I_D = 10\ \mu\text{A}$			5	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{ kHz}$	2.5	7.5		mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{ MHz}$		6.5		pF
帰還容量	C_{rss}			1.9		pF
雑音指数	NF	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0, R_g = 100\text{ k}\Omega, f = 120\text{ Hz}$		0.5		dB

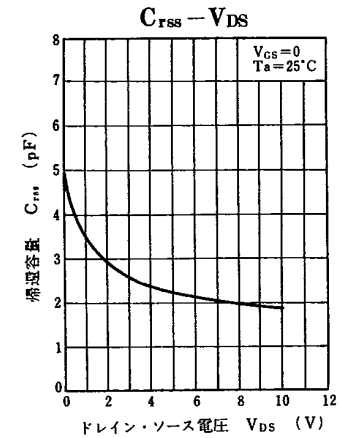
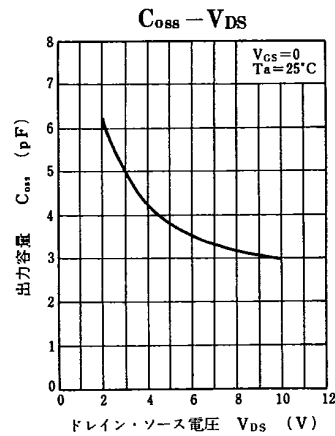
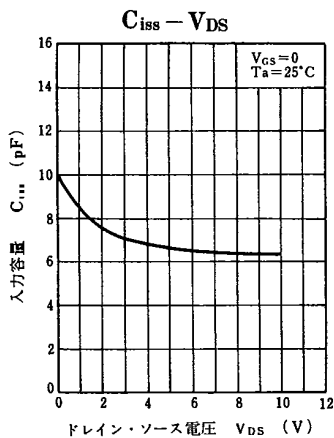
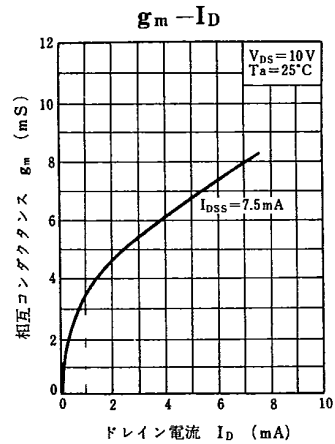
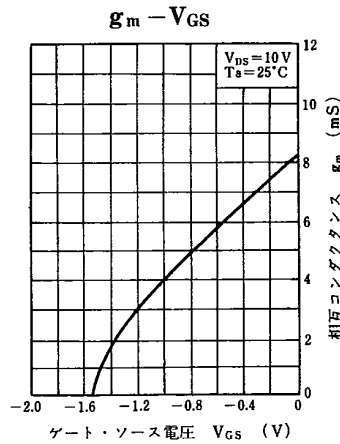
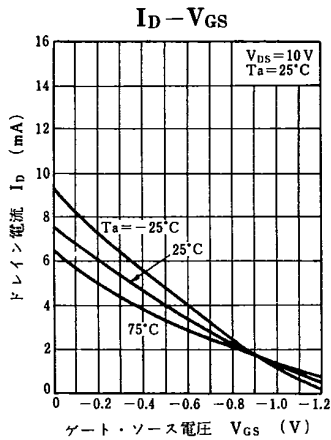
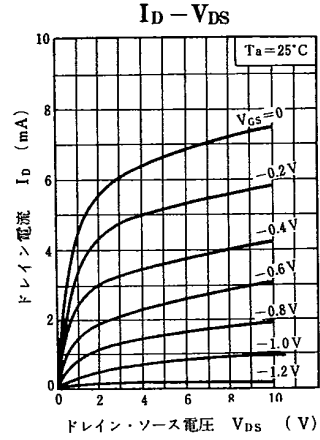
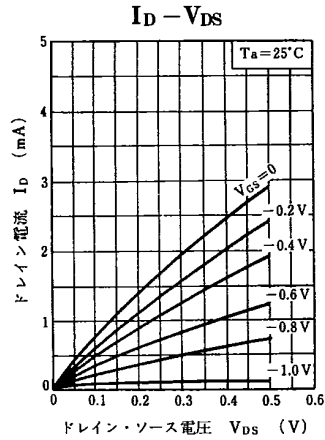
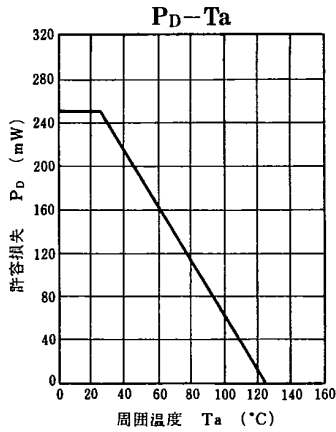
* I_{DSS} ランク分類 / I_{DSS} Classifications

Class	P	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	1~3	2~6.5	5~12	10~20

電界効果トランジスタ

2SK301

T-29-25



電界効果トランジスタ

2SK316

2SK316

T-29-25

シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

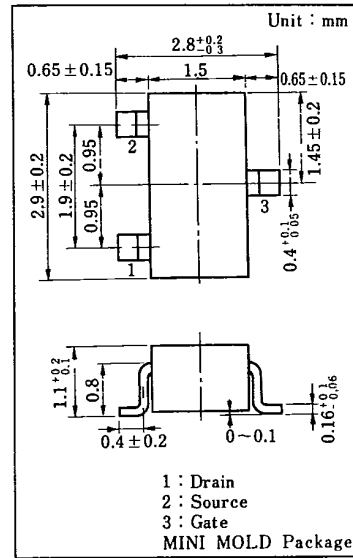
ビデオカメラ初段増幅用 / Video Camera First Stage Amplifier

■ 特徴 / Features

- 入力容量 C_{iss} が小さい。 / Low C_{iss}
- 相互コンダクタンス g_m が高い。 / High g_m

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDO}$	10	V
ゲート・ソース電圧	$-V_{SGO}$	10	V
ドレイン電流	I_D	50	mA
ゲート電流	I_G	5	mA
許容損失	P_D	200	mW
チャンネル部温度	T_{ch}	100	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDO}$	$I_G = 100 \mu\text{A}$	10			V
ゲート・ソース電圧	$-V_{GSO}$	$I_G = 100 \mu\text{A}$	10			V
ゲートシャ断電流	$-I_{GSS}$	$-V_{GS} = 7\text{V}, V_{DS} = 0$			2	nA
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS} = 5\text{V}, V_{GS} = 0$	5		24	mA
ゲート・ソースシャ断電圧	$-V_{GSC}$	$V_{DS} = 5\text{V}, I_D = 100 \mu\text{A}$			3	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS} = 5\text{V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{kHz}$	15			mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 5\text{V}, I_D = 5\text{mA}, f = 1\text{MHz}$			5	pF

* I_{DSS} ランク分類 / I_{DSS} Classifications

Class	P	Q
I_{DSS} (mA)	5~16	14~24
Marking Symbol	1KP	1KQ

電界効果トランジスタ

2SK316

下 29.25

